

Kategorie "Halbleiter-Technologie"

Legende:

- LKVO - Labor für Konstruktion und Versuchswerke Oberspree
 OSW - Oberspreewerk Berlin-Schöneweide
 WFm - Werk für Fernmeldewesen HF
 WFe - Werk für Fernsehelektronik
 FWE - VEB Funkwerk Erfurt

LfdNr	Titel	Autor	Datum	Seiten	Firma	Bilder	Standort
0001	Schaffung von Grundlagen zur Herstellung von Fotohalbleiterschichten	Gaedke	Jun 59	49	WFm	ja	008/0001
0017	Entwicklung und Erprobung von technologischen Verfahren für die Serienfertigung von Germanium-Dioden	Schmidt	Sep 58	36	WFm	ja	008/0015
0060	Bestimmung der Antimon-Arsenverteilung in Germanium-Zwischenlegierungen und Einkristallen	Rößler	Sep 60	33	WFe	ja	008/0051
0069	Untersuchung der Oberflächeneffekte bei Germanium-Spitzendioden	Keiler	Dez 60	39	WFe	ja	008/0059
0075	Herstellung von Silizium-Einkristallen durch Ziehen aus der Schmelze für Si-Dioden	Broll	Dez 60	30	WFe	ja	008/0064
0076	Germanium-Einkristalle für gewünschte Diodentypen	Schröder	Dez 60	44	WFe	ja	008/0065
0090	Untersuchung und Entwicklung eines Verfahrens zur Verbesserung der Legierungstechnik für Glasdioden	Beier	Dez 60	14	WFe		008/0078
0362	Themenstudie über Halbleitende AIBIVCV2-Verbindungen	Buhrig	Jun 69	44	Bergakademie Freiberg		008/0332
0372	Optimierung der Glasphasenepitaxie von GaAs _{1-x} Px auf Ga-Substraten im System Ga/HCl/PH ₃ /H ₂	Butter, Bindemann, u.a.	Mai 77	86	Karl-Marx-Universität Leipzig		008/0341
0391	Untersuchungen über das Ätzen von Oberflächen bei Silizium	Keiler, Schober	Sep 61	50	WFe	ja	008/0360
0414	Technologische Prozesse bei der Detektorherstellung	Böhm	Dez 54	44	WFm	ja	008/0381
0416	Herstellung von Silizium-Einkristallen	Schmidt	Dez 57	29	WFm		008/0383
0417	Silizium-Einkristalle - Anlagenband	Schmidt	Mrz 58	21	WFm	ja	008/0383a
0483	Anwendung des Emanier-Verfahrens zur Bestimmung von Kristalloberflächen und Kristallstrukturänderungen	Rößler	Sep 62	19	WFe		008/0447
0492	Ätzen von Silizium-Bauelementen	Keiler, Schober	Sep 62	18	WFe		008/0456
0500	Kristall- und Dotierungsfragen für Tunnelioden	Hornung, Broll	Dez 62	24	WFe	ja	008/0464
0508	Bestimmung der Verteilung und der Konzentration des Dotierungsmaterials in Siliziumeinkristallen durch Reaktoraktivierung	Rößler	Mrz 62	26	WFe	ja	008/0470
0540	Herstellen von Grundmaterial für Schaltdioden im ns-Bereich	Preschel	Dez 63	26	WFe	ja	008/0502

0553	Bestimmung feinsten Undichtigkeiten in hermetisch abgeschlossenen Systemen, wie z.B. Halbleiterdioden	Rößler, Böhm	Jun 63	27	WFe	ja	008/0515
0579	Untersuchungen über die Photoleitung von mit Gold dotiertem Germanium	Auth, Hermann	Mrz 63	23	WFe		008/0542
0587	Silizium-Einkristalle für Dioden mit Sperrspannungen bis 300 V	Leitloff, Hornung	Sep 63	37	WFe	ja	008/0550
0591	Kristall- und Dotierungsfragen für Dioden mit geringer Sperrtragheit	Broll, Leitloff	Dez 63	33	WFe		008/0554
0618	Studienentwurf zur Entwicklung von Dioden für den Einsatz bei 8 mm Wellenlänge	Heise	Sep 64	37	WFe	ja	008/0581
0629	Gallium-Arsenid-Einkristalle für Tunneldioden	Kunze	Mrz 64	28	WFe	ja	008/0592
0651	Spezielle Untersuchungen von Montagemöglichkeiten bei Ge-Spitzendioden	Eichelbaum, Rentsch	Jun 65	17	WFe		008/0615
0658	Untersuchungen zur Züchtung stark dotierter Silizium-Einkristalle für niedersperrende Dioden und Epitaxiebaulemente	Kunze, Broll	Mrz 65	26	WFe	ja	008/0622
0663	Entwicklung einer Montagestrecke, unter Verwendung von getrockneter Luft, für die Fertigung von Golddrahtdioden	Kanitz, Weise, Mustereit	Jun 65	22	WFe	ja	008/0627
0677	Verfahren für Schaltdioden	Heise u.a.	Sep 65	25	WFe		008/0641
0692	Klärung der physikalischen und technologischen Voraussetzungen zur Herstellung von p/n-Übergängen mit homogenem Lawinendurchbruch (Avalanche-Dioden), die zur direkten Mikrowellenerzeugung geeignet sind	Ehwald, Thamm, Claßen	Sep 66	25	WFe	ja	008/0656
0728	Erarbeitung eines Verfahrens zur Herstellung von Si-Zener-Dioden auf Planar-Diffusions-Basis	Letz	Sep 69	21	WFe		008/0687
0771	Schutzschichten auf Si-Oberflächen	Beister, u.a.	Jun 68	52	WFe		008/0729
0775	Plastverkappung für Si-Schaltdioden	Gruben, u.a.	Apr 71	10	WFe		008/0733
0848	Rationalisierung und Weiterentwicklung der Technologie für Festkörpersymbolanzeigebaulemente	Müller	Mai 77	22	WFe		008/0807
0854	Rationalisierung der VK 11 / VK 12 - Technologie	Schünemann, Illgner, Thämel	Jan 78	3	WFe		008/0813
0857	AME-Komplex Epitaxie	k.A.	1977	6	WFe		008/0816
0863	Störstellen im GaP	Ludwig	Dez 77	150	WFe	ja	008/0822
0865	V(λ) - Anpassung eines Si-Strahlungsempfängers	Schmidt	Jun 78	43	WFe	ja	008/0824
0867	Rationalisierung Zyklus I für Festkörpersymbolanzeigebaulemente	Müller	Dez 78	25	WFe		008/0826
0879	Plastwerkstoffe für optoelektronische Baulemente	Hytry	1978	103	WFe		008/0838
0883	Rationalisierung Montageprozeß (Optoelektronik)	Fehlinger	1978	57	WFe		008/0842
0887	Epitaxierte Halbleiterscheibe IL 5/0	Krause	Nov 78	5	WFe		008/0846
0891	Überleitung von Verfahren zur Fertigung eines Si-Dioden-Targets	Morawski, u.a.	1978	43	WFe		008/0850
0893	Technologische Grundsatzuntersuchungen	Munte	Jul 79	13	WFe		008/0852

	(HL)						
0901	Hochproduktive Umhüllungsverfahren für LED	Haake	Mai 79	9	WFe		008/0860
0903	Plastwerkstoffe für Halbleiterbauelemente des WFB	Treske	Jun 79	12	WFe		008/0862
0904	GPE - Teilsysteme	Sydow	Aug 79	11	WFe		008/0863
0917	Neue Z-Dioden Technologie	Pöhl	Mai 80	50	WFe		008/0876
0920	Alphanumerische LED-Anzeige (A4-Studie)	k.A.	1979	11	WFe		008/0879
0922	Weiterentwicklung der Technologie Zyklus II für GaP-Bauelemente, einschließlich Lichtschachttechnik	k.A.	1979	30	Wfe		008/0881
0924	VQA 35 Technologie	Geese?	Jan 81	11	WFe		008/0883
0931	Rationalisierung Epitaxie	Kirstein, u.a.	Apr 81	12	WFe		008/0890
0938	Optimierung Zyklus I	Müller, u.a.	Feb 81	12	WFe		008/0897
0942	LCD-Grundtechnologie	Seidel	Jun 81	6	WFe		008/0901
0949	Verschlußverfahren für MGG, spezielles für VQB 76	Tittel, u.a.	Sep 80	10	WFe		008/0908
0953	Neue Verfahren Zyklus I - LED	Mardaus	Jul 81	16	WFe		008/0912
0954	Oberflächenveredelung Zyklus II für optoelektronische Bauelemente	Dietzel	Nov 81	11	WFe		008/0913
0959	Umstellung der Vergießtechnologie auf Polyurethan aus DDR-Aufkommen	Brodereck	Mrz 73	17	WFe		008/0918
0974	Grundlagen der Bildung einkristalliner dünner Schichten auf Epitaxie-Basis	Ickert, u.a.	Dez 72	200	HU (WFe)	ja	008/0933
0975	Vorgänge bei der Kontaktierung elektronischer Bauelemente	Engel, u.a.	Dez 72	124	HU (WFe)	ja	008/0934
0976	Mikrowellenimpedanz-Besonderheiten von Halbleitern in schwachen Magnetfeldern bei tiefen Temperaturen	Hermann	Nov 72	109	HU (WFe)	ja	008/0935
0989	Weiterentwicklung der Silizium-Technologie	Keiler	Mrz 74	46	WFe		008/0948
0990	Modifizierte Plastbauform (für HL-BE)	Gruban	Aug 74	14	WFe		008/0949
1019	Integrierte fotoempfindliche Strukturen	Trompter, u.a.	Dez 75	66	WFe	ja	008/0978
1036	Verschlußverfahren für spezielle Halbleiterbauelemente	Tittel	Jun 82	28	WFe		008/1002
1037	Einführung der 51 mm Si-Einkristallscheiben	Keiler	Mrz 82	32	WFe		008/1003
1039	Verbindungshalbleiterepitaxie	Diegner	1982	11	WFe		008/1005
1046	Erweiterung Grundtechnologie Zyklus II	Claus	Mai 82	79	WFe		008/1012
1047	Lichtschacht-Technologie	Rößler	1982	23	WFe		008/1013
1048	Schablonenfertigung	Sellrie	Nov 81	38	WFe		008/1014
1051	BCCD-Technik I	Morawski	Jun 82	41	WFe		008/1017
1053	Weiterentwicklung VQB 37-Technologie	Henseler	Jun 82	5	WFe		008/1019
1059	Weiterentwicklung Montagetechnologie HL	Kuphal	Mrz 83	11	WFe		008/1025
1060	Ausbeuteerhöhung Zyklus I	Müller	Jun 83	16	WFe		008/1026
1066	LCD-Grundtechnologie I	Seidel	Mai 83	17	WFe		008/1032
1067	Ablösung von Verschlußmaterialien für LCD-Bauelemente	Kwiatowski	Apr 83	22	WFe		008/1033
1071	Schablonenfertigung	Sellrie	Jun 83	13	WFe		008/1037
1074	Rationalisierung Oberflächenveredelung	Dietzel	Sep 83	20	WFe		008/1040

	Zyklus II für optoelektronische BE						
1075	GaAlAs-Technologie	Schwarz	Jul 83	14	WFe		008/1041
1081	Verbindungshalbleiter für Infrarot-Anwendungen > 1 µm	Wiegner	1983	12	WFe		008/1047
1088	LC-Mischungsentwicklung I (WO-819) (für Flüssigkristall-BE)	Herzberg	Nov 83	26	WFe		008/1054
1089	Montagetechnologie edelmetallfreier optoelektronischer Bauelemente	Klampfl	1984	5	WFe		008/1055
1091	Musterbautechnologie für Lichtemitterbauelemente	Schünemann	1984	6	WFe		008/1057
1096	CCD-Technologie Zyklus I	Ellmer	Mai 84	29	WFe		008/1062
1100	Optimierung Zyklus I für Streifenstrukturen	Mardaus	Okt 84	22	WFe		008/1066
1102	Entwicklung der Technologie neuer LC-Bauelemente (Flüssigkristall-BE)	Herzig, u.a.	Dez 84	21	WFe		008/1068
1106	Untersuchungen zum Einsatz neuer LED-Materialien	Streese	Jan 85	7	WFe		008/1072
1108	Flexible Nutzung Zyklus II-Verfahren, Infrarotemitterdiode VQ 125	Heymann, Denecke	Sep 84	19	WFe		008/1074
1119	Flexible Nutzung Zyklus II-Verfahren, Fototransistor SP 213	Heymann, Denecke	Okt 83	16	WFe		008/1085
1120	Rationalisierung Kopplerfertigung (LED-PhTr)	Dobrowolny	Mrz 85	5	WFe		008/1086
1124	LCD-Grundtechnologie II	Seidel, u.a.	Feb 85	14	WFe		008/1090
1125	Plasthermetisierungstechnologie für kleine multiplexierbare LCD's (Plast-Gehäuse)	Friedrich	Jun 85	19	WFe		008/1091
1128	Montagetechnologie edelmetallfreier optoelektronischer Bauelemente	k.A.	Dez 85	4	WFe		008/1094
1132	Neue Werkstoffe und Technologien der Oberflächenveredlung Zyklus II	Schneider	Mrz 85	20	WFe		008/1097
1133	Einführung der 100 mm-Si-Scheibe	Otto	Okt 85	18	WFe		008/1098
1135	Neue Lichtschacht-Materialien (Gehäuse-Technologie für LED-Anzeige-BE)	Tessmann	Dez 85	10	WFe		008/1100
1141	Kapazitätserweiterung der LC-Plasthermetisierungstechnologie (Plast-Gehäuse für Flüssigkristall-BE)	Friedrich	Okt 85	49	WFe	ja	008/1106
1142	LC-Mischungsentwicklung II (für Flüssigkristall-BE)	Herzberg	Aug 85	14	WFe		008/1107
1143	Technologische Grundsatzuntersuchungen für großflächige alpha-numerische LC-Displays	Ladwig	Nov 85	13	Wfe		008/1108
1145	Optoelektronische Bauelemente und Verfahren III	Sturm, u.a.	Dez 85	27	WFe		008/1110
1147	Schaltkreisentwurfs-Methodik	Dr. Falter, u.a.	Okt 85	14	WFe		008/1112
1150	Verfahren zur Verringerung von Degradation der VQ 130	Trompter	Nov 85	11	WFe		008/1115
1152	Perspektivisches Epitaxie- und Chipkonzept für sichtbare LED	Kloth, u.a.	Mrz 86	ca. 45	WFe	ja	008/1117
1157	Ga Al As - Technologie	Szuszinski, u.a.	Mai 86	13	WFe		008/1122
1159	BCCD II - Technologie	Ellmer	Dez 86	27	WFe		008/1124
1161	Montagetechnologie edelmetallfreier optoelektronischer Bauelemente	k.A.	1986	3	WFe		008/1126

1167	Vorbereitung Produktionsaufnahme CCD-Keramikgehäuse für MOEZ	Mayer	Mai 87	60	WFe		008/1131
1168	Rationalisierung der partiellen Veredlung Zyklus rom 2	Schneider	Mrz 87	19	WFe		008/1132
1172	Rationalisierung Zyklus rom II integrierter Bauelemente	Richter, u.a.	Mrz 87	5	WFe		008/1136
1173	Rationalisierung und Weiterentwicklung der LCD-Technologie	Friedrich, Herzig, u.a.	Okt 87	12	WFe		008/1137
1175	Vorbereitung Technologie 100 mm - Si-Scheiben	Otto, u.a.	Mai 87	13	WFe		008/1139
1177	Schablonenfertigung I	Sellrie	Nov 87	18	WFe		008/1141
1181	Flexible Nutzung Z. II (techn. Weiterentwicklungen, z.B. Rückseitenkontaktierung)	Heymann, Denecke	Mai 87	10	WFe		008/1145
1183	Technologische Grundsatzuntersuchungen zum Zykl. 2	Schulz, u.a.	Sep 87	15	WFe		008/1147
1186	LCD-Mischungsentwicklung IV	Herzberg	Okt 87	18	WFe		008/1150
1190	Diagnoseverfahren (zur Absicherung neuartiger HL-Technologien)	Richter, u.a.	Dez 87	103	WFe	ja	008/1154
1370	Entwicklung eines Verfahrens zur Herstellung von Einkristallen für höchstempfindliche Detektoren - OSW 2563	Pr/Ha	Dez 48	41	OSW	ja	068/0177
1470	Halleffektmessungen an Bleisulfid, Bleiselenuid, Cadmiumsulfid, Selen	k.A.	k.A.	67	WFm	ja	068/0288
1500	Untersuchung über die lichtelektrische Wirkung und Lumineszenz von Halbleitern	Ingrid Poppe	Mai 51	55	WFm		068/0330
1620	Physikalische Eigenschaften, Anwendung und Technologie der Halbleiter	k.A.	Jul 46	16	OSW		068/0760
1838	Löten von LFDs - Entwicklung und Aufbau einer automatischen Temperatursteuerung	W. Ladewig	Jan 85	109	Humboldt-Universität zu Berlin	ja	D02/0068
1846	Chipfügen - Teil 1: Flächenhaftes Fügen von A III - B V - Halbleitern	J.-M. Labs	Mai 77	155	WFe		D08/0982-1
1847	Chipfügen - Teil 2: Bild- und Tafelzusammenstellung	J.-M. Labs	Mai 77	97	WFe	ja	D08/0982-2
1850	NIR-Detektor - Physikalische und technologische Grundlagen für Fotodioden mit $\lambda_g \leq 1,6 \mu\text{m}$	Wandel	Mai 84	3	Humboldt-Universität zu Berlin		D08/1400-A1
1851	Halbleitermaterial für die Optoelektronik	Unger, Kühn, ua	Dez 80	33	KMU Leipzig		D08/1401
1852	Verbindungshalbleiter für die Optoelektronik	Unger, Kühn, ua	Dez 85	21	WFe		D08/1403
1853	Untersuchungen an transparenten, elektrisch leitenden SnO ₂ -Schichten	Ladwig	Mai 62	126	Technische Universität Dresden	ja	D08/1404
1854	Kontaktierung und Diagnostik	Scheel	k.A.	72	Humboldt-Universität zu Berlin		D08/1407
1855	Untersuchung zum Strahlenschaden in ionenimplantiertem Silizium mit der Rutherford-Rückstreuung von Protonen der Energie 300 keV	Täubner	Sep 80	182	Humboldt-Universität zu Berlin		D08/1749
1856	Zum plasmachemischen Ätzprozeß von GaAs	k.A.	k.A.	26	WFm		D08/1773-3
2034	Fertigungseinführung L220C - Konzeption (Entwurf) -	Dr. Täubner (u.a.)	Dez 88	49	WFe		

	Journal 2/89 - WF Vorlaufforschung						
2043	Ionenbeschuss optoelektronischer Halbleitermaterialien Bd.1/2 - 5290579	Klose	Apr 82	192	WFe / Humboldt Univ. Bln		WF-Vorlauf-forsch